

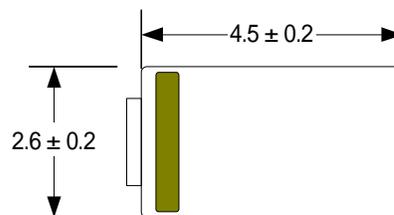
SJPZ-E33
Power Zener Diode

2009年4月

概要

過電圧保護素子として優れた応答性で動作する表面実装型 1W パワーゼナーダイオードです

パッケージ



アプリケーション

- ・カーナビ
- ・エアバッグ
- ・その他電子機器

主要スペック

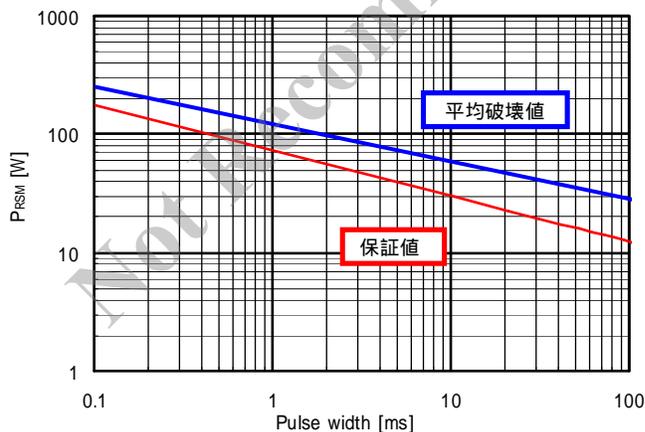
項目	記号	単位	定格	条件
許容電力損失	P	W	1	ガラス球形 基板実装
ピーク逆耐電力	P_{RSM}	W	95 min	500 μ s 矩形波 単発
逆方向降伏電圧	V_Z	V	31.0 ~ 35.0	$I_Z=1mA$
逆方向漏れ電流	I_R	μ A	10 max	$V_R=25V$

特長

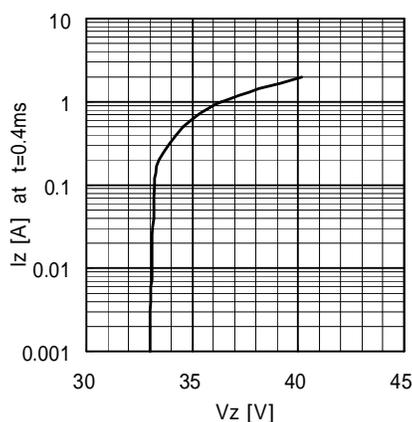
- ・平均電力損失 1W の 2 端子面実装型
- ・高逆サージ耐量と高 ESD 耐量を確保

代表特性

ピーク逆耐電力破壊値 P_{RSM}



逆方向降伏電圧 - 逆方向降伏電流特性 $V_Z - I_Z$
 V_Z typ.品 at $I_Z=1mA$



SJPZ-E33
Power Zener Diode

2009 年 4 月

★ 絶対最大定格

製品名			SJPZ-E33	
項 目	記号	単位	定 格	条 件
許容電力損失	P	W	1	次頁の図 P - T a 参照
ピーク逆耐電力	P_{RSM}	W	95 min.	500 μ s 矩形波単発
接合部温度	T_j		-55 ~ +150	-
保存温度	T_{stg}		-55 ~ +150	-

★ 電気的特性(特に指定の無い場合は、25 $^{\circ}$ C とする。)

製品名			SJPZ-E33	
項 目	記号	単位	定 格	条 件
逆方向降伏電圧	V_Z	V	31.0 ~ 35.0	$I_Z=1mA$
逆方向漏れ電流	I_R	μA	10 max.	$V_R=25V$
降伏電圧温度依存性	z	mV/	28 typ.	$I_Z=1mA$
降伏領域等価抵抗	R_Z		10 typ.	$I_Z=10mA \sim 20mA$

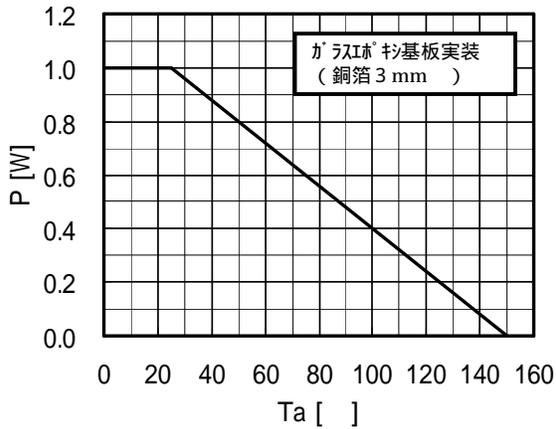
SJPZ-E33

2009 年 4 月

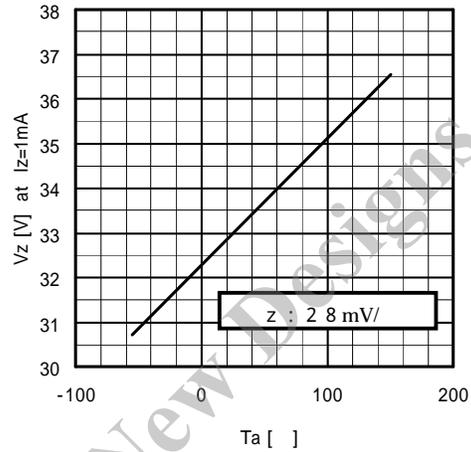
Power Zener Diode

★ 特性

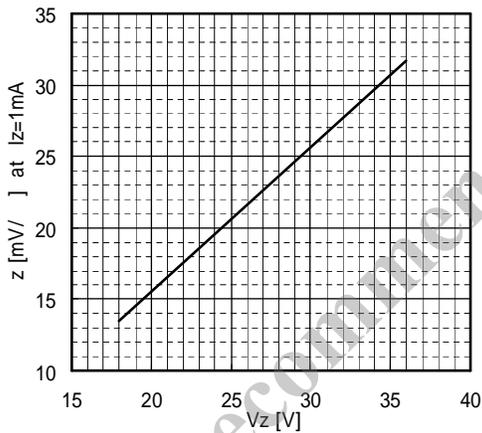
許容電力損失 - 周囲温度特性 P - Ta



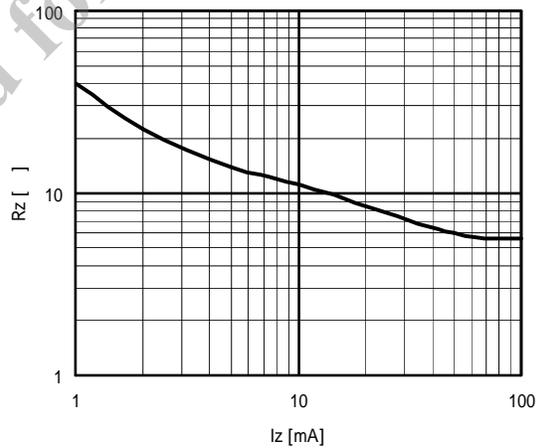
逆方向降伏電圧 - 周囲温度特性 Vz - Ta
Vz typ.品 at Iz=1mA



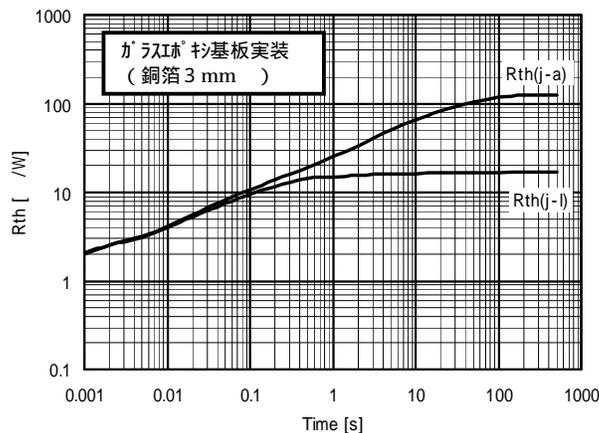
逆方向降伏電圧 - 降伏電圧温度係数特性 Vz - z



降伏領域等価抵抗 - 逆方向降伏電流特性 Rz - Iz
Vz typ.品 at Iz=1mA



過渡熱抵抗特性 Rth

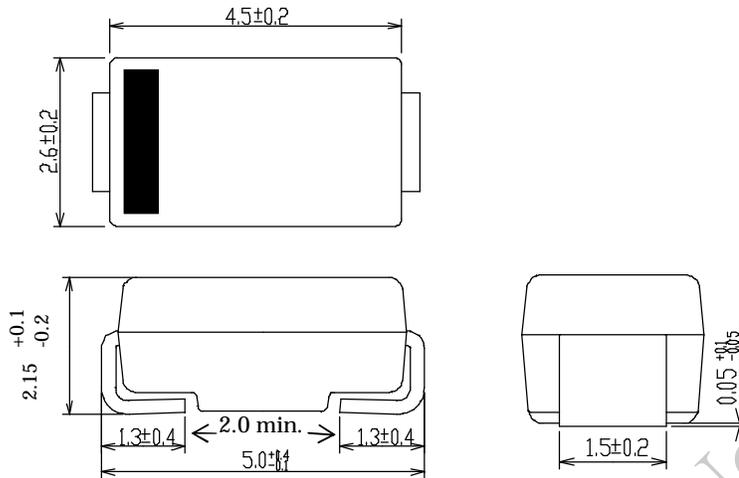


SJPZ-E33

2009 年 4 月

Power Zener Diode

外形図 (mm)



接続図

